УДК 621.391

#### РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

DOI 10.53297/0002306X-2021.3.v74-325

#### М.С. АЗОЯН, Д.А. КАЗАРЯН

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ УМНОЖИТЕЛЕЙ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Проведено экспериментальное исследование транзисторных параметрических умножителей сверхвысоких частот (СВЧ). Для расчета преобразователей СВЧ за основу принимаются экспериментально снятые вольт-амперные и вольт-кулоновые характеристики (ВАХ и ВКХ) нелинейного элемента. Задача решается графоаналитическим методом выбором необходимого количества производных от указанных характеристик, значения которых являются исходными.

*Ключевые слова*: гармоника, умножитель частоты, накачка, активный, реактивный, проводимость.

Введение. В настоящее время в связи с развитием телекоммуникации появилась потребность в создании надежных и малогабаритных приборов СВЧ с широкими функциональными возможностями [1], в том числе умножителей частоты, которые особенно эффективны в дециметровом и сантиметровом диапазонах частот в качестве буферной цепи передатчиков [2]. Поэтому транзисторный параметрический умножитель частоты (ТПУЧ) обладает одновременно свойствами усиления и умножения частоты входного сигнала.

**Методы исследования.** Из уравнений (1) и (2) на основе синтеза [3] следует, что нелинейная проводимость коллекторного p-n перехода, эквивалентная схема которого представляется в виде параллельно включенных проводимости и емкости, вносит в контуры накачки и гармоники активные и реактивные проводимости:

$$\begin{split} \dot{Y_1} &= -\sum_{p=0}^{\infty} \cdot G^1{}_{n(p+1)} sinn(p+1)\varphi + n\omega \sum_{p=1}^{\infty} \cdot C^1{}_{n(p-1)} sinn(p-1)\varphi + \\ &+ j[\sum_{p=0}^{\infty} \cdot G^1{}_{n(p+1)} cosn(p+1)\varphi + n\omega \sum_{p=1}^{\infty} \cdot C^1{}_{n(p-1)} cosn(p-1)\varphi], \quad (1) \\ &\dot{Y_n} &= -\omega \sum_{p=0}^{\infty} \cdot C^n{}_{n(p+1)} sinnp\varphi + \sum_{p=1}^{\infty} \cdot G^n{}_{np-1} sinnp\varphi + \\ &+ j[\omega \sum_{p=0}^{\infty} \cdot C^n{}_{np+1} cosnp\varphi + \sum_{p=1}^{\infty} \cdot G^n{}_{np-1} cosnp\varphi]. \quad (2) \end{split}$$

Принимая, что выходной сигнал есть n-я гармоника входного колебания, из этих выражений видно, что в случае  $0 < \varphi < \pi$  нелинейная емкость вносит в контур накачки потери, а в контур гармоники - отрицательную проводимость, т.е. в системе может быть задействован режим перекачивания энергии из одного контура в другой. При этом могут появляться гармонические колебания.

При воздействии двухчастотного сигнала на нелинейную емкость напряжением от емкости C в контур накачки вносятся активные и реактивные составляющие проводимости  $G_1$  и  $C_1$ , а в контур субгармоники -  $G_n$  и  $C_n$ . Следовательно, в процессе преобразования образуются проводимости пассивных потерь в контурах накачки -  $G_{s_1}$  и субгармоники -  $G_{s_n}$ :

$$U_{\Sigma} = U_0 + U_1 cos\omega t + U_n cos(n\omega t + \varphi). \tag{3}$$

На основе полученных соотношений для делителя частоты построены эквивалентные схемы для контуров накачки (рис.1а) и гармоники (рис.1б).

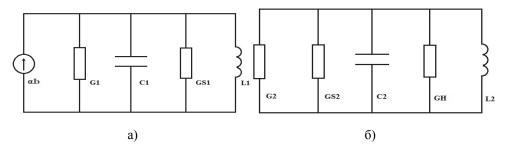


Рис. 1. Эквивалентные схемы контуров ТПУЧ: а - для сигнала накачки, б - для сигнала гармоники

На рис. 1 приняты следующие обозначения:  $G_1$  - потери на образование гармоники;  $G_{s1}$  — пассивные потери в контуре входного сигнала;  $C_1$  — эквивалентная емкость на частоте сигнала накачки;  $L_1$  - внешняя индуктивность сигнального контура;  $G_2$  — отрицательная проводимость, вносимая в контур гармоники;  $G_{s2}$  - пассивные потери в контуре гармоники;  $C_2$  — эквивалентная емкость на частоте гармоники;  $G_{\rm H}$  — проводимость нагрузки;  $L_2$  - внешняя индуктивность контура гармоники.

Следует учесть то обстоятельство, что ВКХ и ВАХ не имеют аналитических выражений, сняты экспериментально для любого нелинейного элемента.

В итоге для упомянутых проводимостей получаем следующие приближенные аналитические выражения:

- для контура накачки:

$$G_1 = -G_n^1 \sin \varphi, C_1 = C_0^1 + \frac{1}{n\omega} G_n' \cos \varphi,$$

$$G_1^1 = G_0^{1\prime} + G_n^{1\prime} \cos\varphi, C_1' = G_n^{1\prime} \sin\varphi;$$
 (4)

- для контура гармоники:

$$G_{n} = G_{n-1}^{n} sinn\varphi, C_{n} = C_{1}^{n} + \frac{1}{\omega} G_{n-1}^{n} cosn\varphi,$$

$$G'_{n} = G_{1}^{n'} + G_{n-1}^{n'} cosn\varphi, C'_{n} = -G_{n-1}^{n'} sinn\varphi.$$
(5)

С учетом (4) и (5) компоненты, обозначенные на рис.1а,б, выражаются соотношениями

$$G_{1} = G_{n}^{n} sin\varphi, C_{1} = C_{0}^{n} + \frac{1}{\omega} G_{n}^{n} cos\varphi,$$

$$G_{2} = -G_{n-1}^{1} sinn\varphi, C_{2} = C_{1}^{1} + \frac{n}{\omega} G_{n-1}^{1} cosn\varphi.$$

Условие самовозбуждения в контуре гармоники выполняется с учетом [3]

$$G_{n-1}^1 sinn\varphi + G_{s2} = 0,$$

которое совпадает с уравнением стационарного режима автогенератора, а уравнение, определяющее фазу  $\varphi$  в системе, можно записать в виде

$$\frac{\omega}{n}C_1^1 + G_{n-1}^1 \cos\varphi - \frac{n}{\omega L^2} = 0.$$

Исключая в последних уравнениях фазу, решением параметрического уравнения относительно напряжения накачки, при условии резонанса в обоих контурах и при n=2, соотношение, определяющее напряжение выходного контура, примет вид

$$U_2 = \sqrt{\frac{4\alpha I_9}{\omega A_2} - \frac{16G_{s1}G_{s2}}{\omega^2 A_2^2}}.$$

Очевидно, что при  $\alpha I_3 < \frac{4G_{s1}G_{s2}}{\omega A_2}$  никакое внешнее воздействие не приведет к самовозбуждению системы, а при обратном неравенстве [4]

$$\alpha I_{9} > \frac{4G_{s1}G_{s2}}{\omega A_{2}}$$

выполняется условие возбуждения, причем чем больше  $\alpha I_{\scriptscriptstyle 3}$ , тем больше  $U_{\scriptscriptstyle 2}$ .

Экспериментальное исследование ТПУЧ проведено на транзисторе КТ640A2 по схеме с общей базой (рис.2).

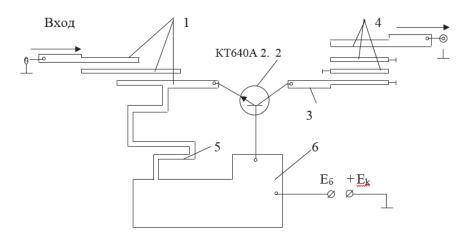


Рис. 2. Схема экспериментального макета ТПУЧ на транзисторе КТ640A2; 1 - фильтр входного сигнала с частотой накачки; 2 - транзистор КТ640A2; 3 - резонатор гармоники — выходного сигнала; 4 - фильтр выходного сигнала с частотой гармоники; 5 - дроссель в цепи питания; 6 - блокировочная емкость в цепи базы

Экспериментально исследованы и сняты амплитудно-частотные характеристики умножителя частоты на два (рис.3а) и энергетические зависимости выходной мощности от напряжения питания (рис.3б) при фиксированных уровнях накачки, результаты которых однозначно совпадают с расчётными.

Экспериментальный макет (рис.4) реализован также на транзисторе, специально разработанном для полосковых радиочастотных конструкций в области дециметровых и сантиметровых длин волн типов 2Т371A, КТ372Б, КТ640A2, КТ918A, КТ634A, 2Т938A-2.

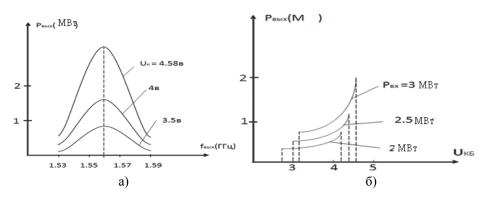


Рис.3. Экспериментально снятые характеристики ТПУЧ: a – частотные и б – энергетические

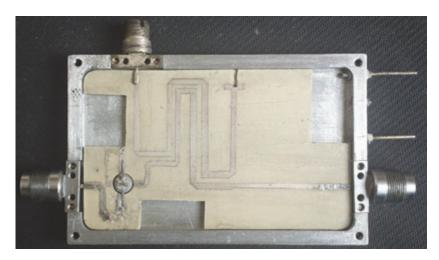


Рис. 4. Экспериментальный макет транзисторного параметрического умножителя *CBY* 

**Заключение.** Реализованы и экспериментально исследованы макеты транзисторных умножителей СВЧ для устройств на полосковых линиях.

Обосновано использование предложенных методов расчета для проектирования преобразующих и передающих устройств сигналов СВЧ в области дециметровых и сантиметровых длин волн при разработке современных радиотехнических средств телекоммуникации.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Твердотельные устройства СВЧ в технике связи / **Л.А.** Гасанов и др. -М.: Радио и связь, 1988.- 288с.
- Free non-Reciprocity and isolation based on parametrically modulated coupled-resonator loops / Nicholas A. Estep, Dimitrios L. Jacson Soric and Andrea Alu Magnetic // Nature Physics Macmillan Publishers Limited. - 2014. – P. 1-5.
- 3. **Азоян М.С.** Вывод основных соотношений для полупроводникового параметрического делителя СВЧ //Вестник ГИУА: Информационные технологии, электроника, радиотехника. 2015. N1. C.91-97.
- 4. **Азоян М.С., Айвазян М.Ц.** Делители сигнала терагерцового диапазона // Известия НАН РА и НПУА. Серия Техн. наук. 2020.- Т.73, N3. С. 277- 286.

Национальный политехнический университет Армении. Материал поступил в редакцию 04.04.2021.

#### Մ.Մ. ԱԶՈՑԱՆ, Դ.Ա. ՂԱԶԱՐՑԱՆ

## ՏՐԱՆՋԻՍՏՈՐԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԱԿԱՆ ԳԵՐԲԱՐՁՐ ՀԱՃԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՉԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Կատարվել է գերբարձր հաճախությամբ (ԳԲՀ) տրանզիստորային պարամետրիկ ձևափոխիչների փորձարարական հետազոտություն։ ԳԲՀ ազդանշանների ձևափոխիչների հաշվարկի հիմքում ընդունում ենք ոչ գծային տարրի վոլտ-ամպերային (ՎԱԲ) և վոլտ-կու-լոնային (ՎԿԲ) փորձնականորեն ստացված բնութագրերը։ Խնդիրը լուծվում է գրաֆա-վերլուծական եղանակով՝ նշված բնութագրերից որոշակի, անհրաժեշտ քանակով ածանց-լայների որոշմամբ, որոնք համարվում են ելակետային։

**Առանցքային բառեր.** ենթահարմոնիկ, հաճախության բազմապատկիչ, մղում, ակտիվ, ռեակտիվ, հաղորդականություն։

### M.S. AZOYAN, D.A. GHAZARYAN

## AN EXPERIMENTAL STUDY OF TRANSISTOR PARAMETRIC MULTIPLIERS OF MICROWAVES

An experimental study of transistor parametric multipliers of microwaves (MW) is performed. For the calculation of microwave converters, experimentally obtained current -voltage (I-V) and current - Coulomb (WSS) characteristics of nonlinear element are taken as a basis. The problem is solved by the graphical-analytical method, by selecting a necessary quantity of derivatives, with a glance of these characteristics, the values of which are original.

*Keywords:* subharmonic, frequency multipier, pump, active, reactive, conductivity.